

●特点: ■击穿电压稳定 ■开关速度快 ■安全工作区宽 ■符合ROHS规范

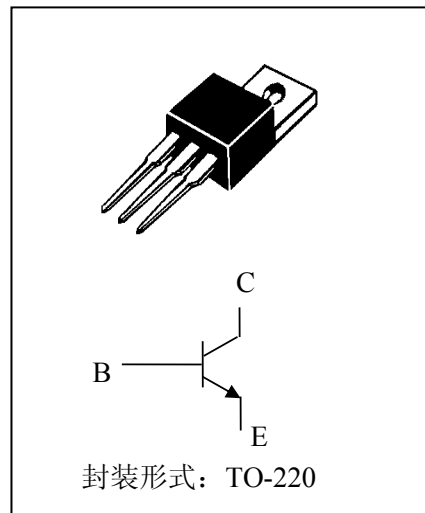
●FEATURES: ■HIGH VOLTAGE CAPABILITY ■HIGH SPEED SWITCHING ■WIDE SOA ■ROHS COMPLIANT

●应用 ■节能灯 ■电子镇流器 ■电子变压器等开关电路

●APPLICATION: ■FLUORESCENT LAMP ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ECT.

● 最大额定值 (TC=25℃) Absolute Maximum Ratings (Tc=25℃)

参数名称 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	VCBO	700	V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	VCEO	400	V
发射极-基极 Emitter-Base Voltage	VEBO	9	V
集电极电流 Collector Current	IC	8	A
集电极耗散功率 Total Power Dissipation	PC	200	W
最高工作温度 Junction Temperature	Tj	150	℃
贮存温度 Storage Temperature	TsTg	-65-150	℃



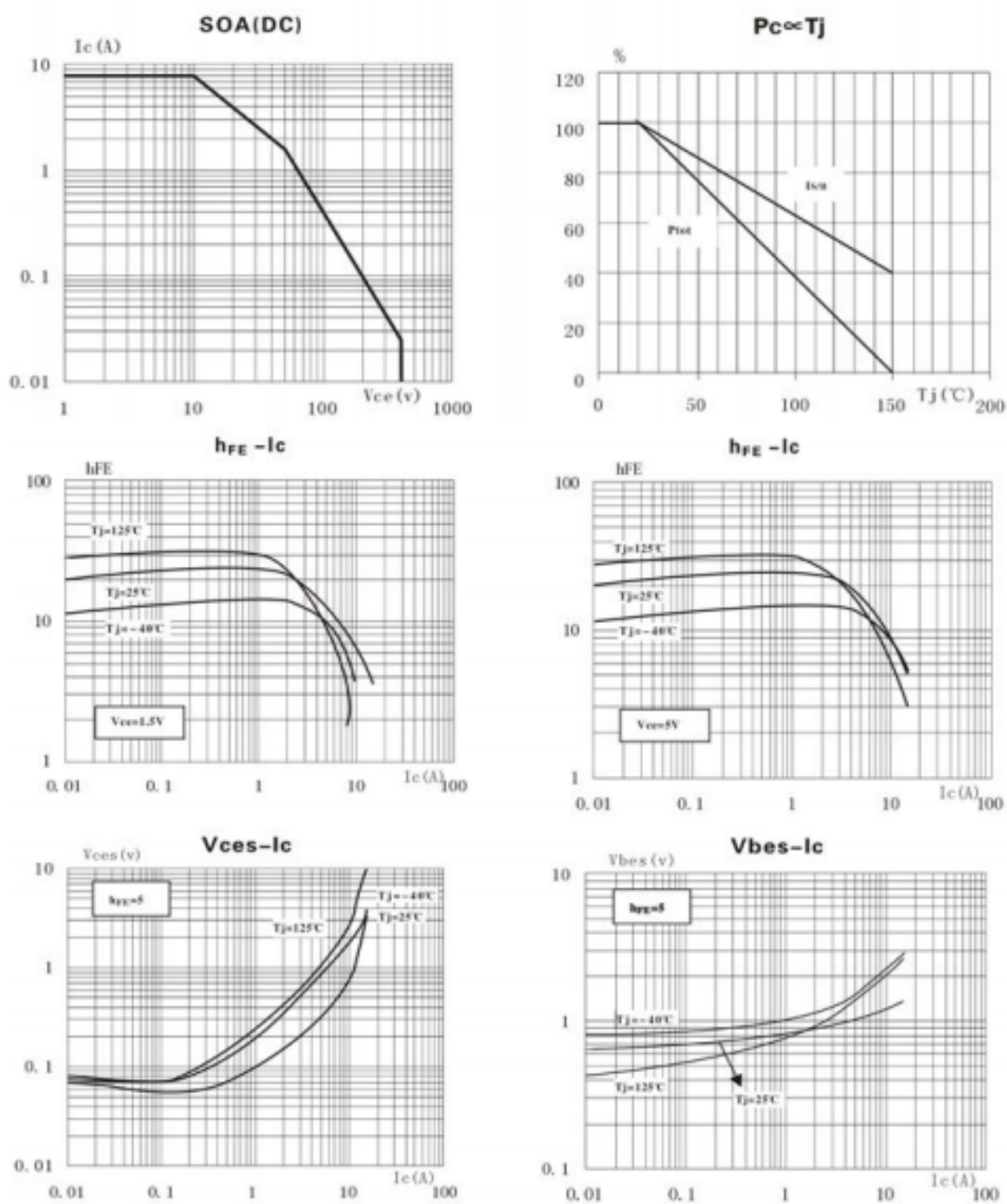
● 电特性 (TC=25℃) Electronic Characteristics (Tc=25℃)

参数名称 CHARACTERISTICS	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	最大值 MAX	单位 UNIT
集电极-基极截止电流 Collector-Base Cutoff Current	ICBO	VCB=700V		5	uA
集电极-发射极截止电流 Collector-Emitter Cutoff Current	ICEO	VCE=400V, IB=0		10	uA
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	VCEO	IC=10mA, IB=0	400		V
发射极-基极电压 Collector-Base Voltage	VEBO	IE=1mA, IC=0	9		V
集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage	Vcesat	IC=2.0A, IB=0.4A		0.35	
		IC=5.0A, IB=1.25A		0.65	V
		IC=8.0A, IB=2.0A		0.9	V
发射极-基极饱和压降 Base-Emitter Saturation Voltage	Vbesat	IC=5.0A, IB=1.25A		1.2	V
电流放大倍数 DC Current Gain	Hfe	VCE=5V, IC=10mA	8		
		VCE=5V, IC=2.0A	20	30	
		VCE=5V, IC=9.0A	6		
贮存时间 Storage Time	ts	VCC=5V IC=0.5A (UI9600)	4.0	8.0	us
下降时间 falling time	tf			1.0	
特征频率	fT	VCE=10V	4	-	MHz
		IC=0.5A			

● 热特性 THERMAL CHARACTERISTICS

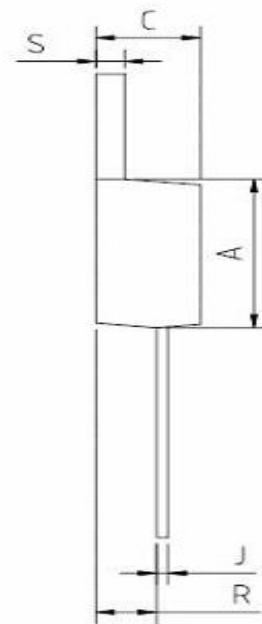
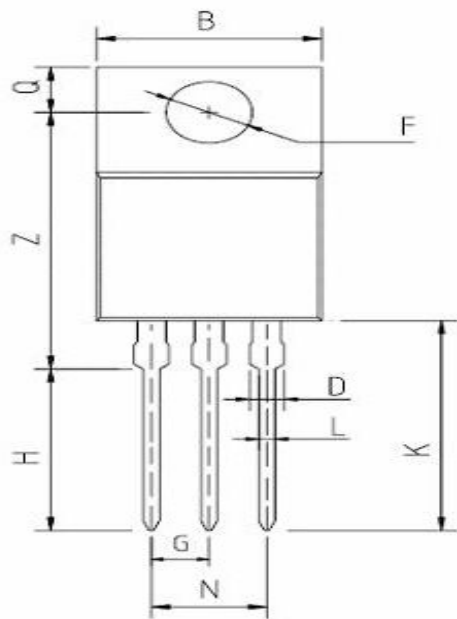
项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小值 Value(min)	最大值 Value(max)	单 位 Unit
结到管壳的热阻 Thermal resistance from junction to case	Rth(j-c)		1.56	℃/W

特性曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)



TO-220 Package Dimensions

UNIT:mm



SYMBOL	Min	Nom	Max
A	9.00	9.20	9.40
B	9.50	10.00	10.50
C	4.20	4.50	4.80
D	1.20	1.25	1.30
F	3.70	3.80	3.90
G		2.54	
H	9.50	10.00	10.50
J	0.37	0.38	0.40
K	13.00	13.50	14.00
L	0.75	0.80	0.85
N		5.08	
P			
Q	2.65	2.75	2.85
R	2.60	2.70	2.80
S	1.20	1.25	1.30
Z	15.80	16.00	16.20